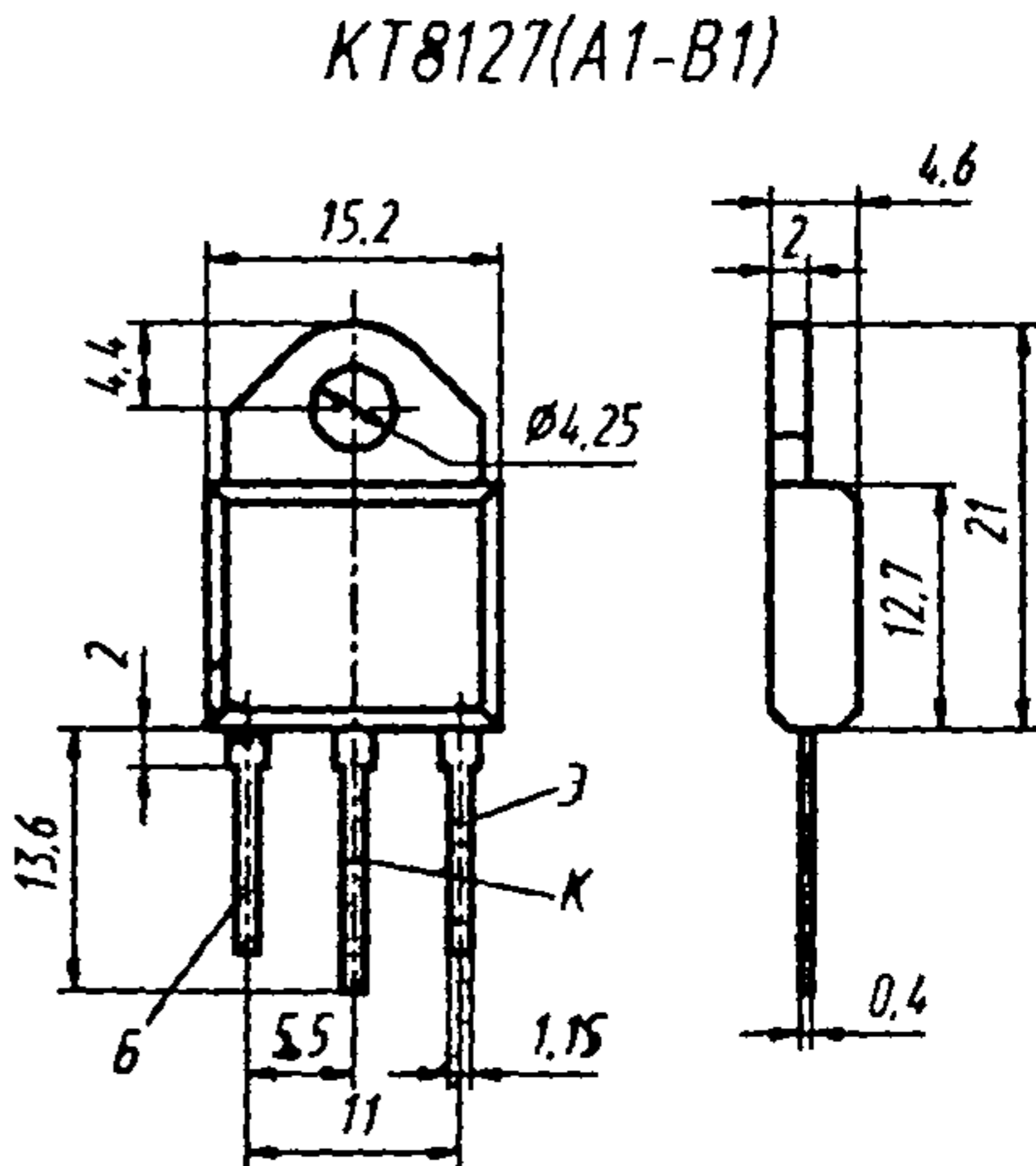


**КТ8127А, КТ8127Б, КТ8127В,
КТ8127А1, КТ8127Б1, КТ8127В1**

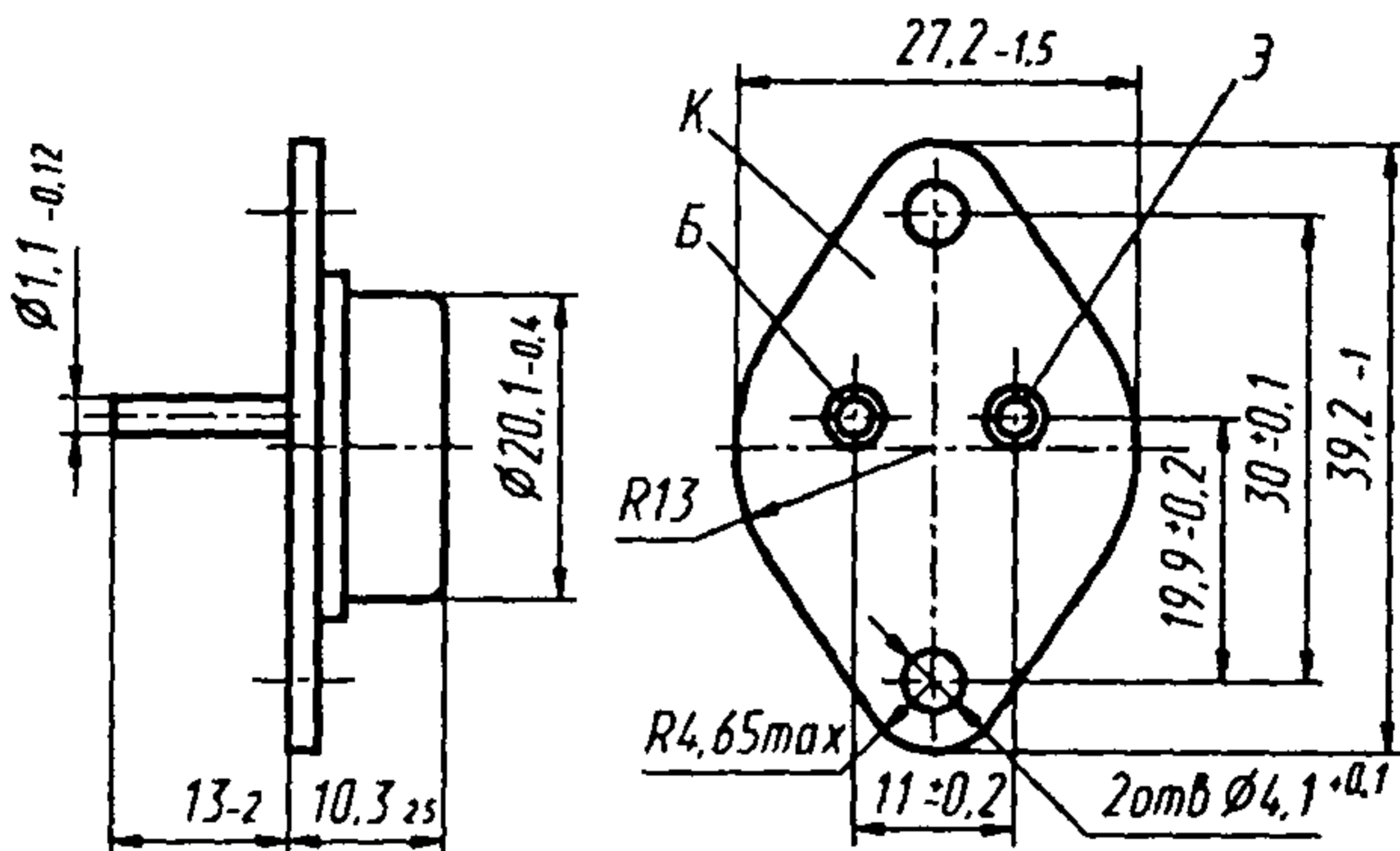
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* переключаемые. Предназначены для применения в схемах строчной развертки и в источниках электропитания. Транзисторы КТ8127А—КТ8127В выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами, КТ8127А1—КТ8127В1 — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, в пластмассовом — не более 10 г.



Изготовитель — ОКБ «ЭлП» ПО «Электронприбор»,
г. Фрязино, Московская область

КТ8127(А-В)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5$ В:

$I_k = 0,5$ А, не более..... 35

$I_k = 0,03$ А для КТ8127Б1, КТ8127В1,
не менее..... 6

Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А,
 $L = 40$ мГн, не менее..... 700 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер,
не более:

$T_k = +25$ °С при $I_k = 4,5$ А, $I_b = 2$ А:

КТ8127А, КТ8127А1..... 1 В

КТ8127Б, КТ8127Б1..... 5 В

КТ8127В, КТ8127В1..... 5 В

$T_k = +100$ °С при $I_k = 4,5$ А, $I_b = 3$ А:

КТ8127А, КТ8127А1..... 2,5 В

КТ8127Б, КТ8127Б1..... 5 В

КТ8127В, КТ8127В1..... 5 В

$T_k = -45$ °С при $I_k = 4,5$ А, $I_b = 3$ А:

КТ8127А, КТ8127А1..... 1,5 В

КТ8127Б, КТ8127Б1..... 5 В

КТ8127В, КТ8127В1..... 5 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 4,5$ А, $I_B = 2$ А, не более	1,5 В
Постоянное напряжение эмиттер—база, не более:	
при $I_K = 0$, $I_B = 0,01$ А	5 В
при $I_K = 0$, $I_B = 0,1$ А	7 В
Время спада при $U_{КЭ} = 500$ В, $U_{БЭ} = -5$ В, $I_K = 4,5$ А, $I_B = 1,4$ А, $t_{и} = 40$ мкс, не более	1 мкс
типовое значение	0,7* мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{МАКС}}$, не более:	
$T_K = +25$ и -45 °С:	
КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1, КТ8127В1	0,9 мА
КТ8127Б, КТ8127Б1	0,6 мА
$T_K = +100$ °С:	
КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1, КТ8127В1	2 мА
КТ8127Б, КТ8127Б1	1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 100$ Ом, $t_{и} = 20$ мкс, $t_{ф} = 2$ мкс, $Q = 4$:	
КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1, КТ8127В1 .	1500 В
КТ8127Б, КТ8127Б1	1200 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	5 А
Импульсный ток коллектора	7,5 А
Импульсный ток базы	4 А
Постоянный запирающий ток базы	0,1 А
Импульсный запирающий ток базы	3,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ при $T_K = -45...+32$ °С	56 Вт
Температура р-п перехода	+115 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус при $U_{КЭ} = 15$ В, $I_K = 0,78$ А	1,6 °С/Вт
Температура окружающей среды	$-45...T_K =$ $= +100$ °С

¹ При $T_K > +32$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{K, \text{МАКС}} = (T_{п} - T_K) / R_{T (п-к)}, \text{ Вт.}$$